

智慧財產及商業法院行政判決

111年度行專訴字第49號

民國112年2月9日辯論終結

原告 友威科技股份有限公司

代表人 李原吉

訴訟代理人 趙嘉文專利師

吳俊億專利師

楊理安律師

被告 經濟部智慧財產局

代表人 洪淑敏

訴訟代理人 簡昭莢

韓薰蘭

參加人 凌嘉科技股份有限公司

代表人 陳連春

訴訟代理人 陳冠宏律師

蔣昕佑律師

陳豫宛專利師

上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國111年6月28日經訴字第11106304550號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加本件訴訟，本院判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、程序事項：

按關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之，智慧財產案件審理法第33條第1項定有明文。原告於舉發時提出證據2至9以證明發明第I 513840號「多層膜的量產方法」專利(下稱系爭專利)請求項1至10不具進步性，於本件行政訴訟階段，則另提出甲證3證

明系爭專利請求項1至10不具進步性，乃就同一撤銷理由所提出之新證據，依智慧財產案件審理法第33條第1項規定，本院就上開新證據，得併予審究。之後，原告於本院112年1月9日準備程序時，當庭表明舉發之證據2至4不再主張，並確認本件新證據組合，有本院準備程序筆錄可憑（見本院卷第329至334頁），故本院審酌範圍為新證據甲證3及證據5至9之組合是否可以證明系爭專利請求項1至10不具進步性。

貳、實體事項：

一、事實概要：

參加人前於民國103年12月25日以「多層膜的量產方法」向被告申請發明專利，申請專利範圍共10項，經被告編為第103145499號審查，准予專利，並發給系爭專利證書。嗣原告以系爭專利違反核准時專利法第22條第2項之規定，對之提起舉發。案經被告審查，以111年3月4日（111）智專三（五）01146字第11120221170號專利舉發審定書為「請求項1至10舉發不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部111年6月28日經訴字第11106304550號決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，倘認訴願決定及原處分應予撤銷，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依職權裁定命其獨立參加本件訴訟。

二、原告聲明請求原處分及訴願決定均撤銷，被告就系爭專利舉發事件(103145499N01)，應作成「請求項1至10舉發成立，應予撤銷」之審定，並主張：

(一)證據6足以證明系爭專利請求項1不具進步性：

系爭專利請求項1之結構特徵部分已被證據6明確揭露，系爭專利請求項1之方法特徵部分，所屬技術領域中具有通常知識者能輕易結合參加人於系爭專利說明書所載之先前技術（參加人自行明文承認之習知技術），以及證據6所揭露及教示之內容，輕易完成系爭專利請求項1之方法特徵內容。是以，系爭專利請求項1之全部技術內容皆已被揭露或可輕易完成，自不具進步性。

01 (二)證據5至證據7及甲證3之組合足以證明系爭專利請求項1不具
02 進步：

03 證據5已揭示多個基板可依序同步移動進行濺鍍工作，證據
04 6、證據7以及甲證3明確揭露系爭專利請求項1步驟(a)的結
05 構特徵，並且證據6、證據7以及甲證3分別揭露多個載具依
06 序排列位於鍍膜生產線中之不同鍍膜區間而可進行鍍膜程序
07 的技術內容，進一步結合證據5以及系爭專利說明書先前技
08 術段落之教示，所屬技術領域中具有通常知識者可輕易完成
09 系爭專利請求項1。

10 (三)證據5至證據8及甲證3之組合足以證明系爭專利之請求項2至
11 9不具進步性：

12 系爭專利請求項2係依附於請求項1，並僅為腔體數量上的變
13 更，而對應進行的步驟增加，不具進步性；系爭專利請求項
14 3係依附於請求項2；系爭專利請求項4係依附於請求項3；系
15 爭專利請求項5係依附於請求項1；系爭專利請求項6係依附
16 於請求項5；系爭專利請求項7係依附於請求項2；系爭專利
17 請求項8係依附於請求項7；系爭專利請求項9係依附於請求
18 項1至8任一項，所屬技術領域中具有通常知識者結合證據5
19 至證據8及甲證3，當可輕易完成系爭專利請求項2至9之內
20 容，足證系爭專利之請求項2至9不具進步性。

21 (四)證據5至證據9及甲證3之組合足以證明系爭專利之請求項10
22 不具進步性：

23 證據9說明書已揭示於一入口閥門（證據9之進料腔體10的入
24 口）、一出口閥門（證據9之出料腔體12的出口）、一連續
25 地設置於該等緩衝區間和該等鍍膜區間內用以傳輸該等載具
26 的傳輸機構（證據9之動力輸出設備13及被動力輸出設備13
27 驅動的輸送滾輪14），及一供該等載具自該出口閥門回流至
28 該入口閥門的自動回流單元（證據9之前置機台18、後置機
29 台19及回傳機構模組40），該自動回流單元包括一銜接該出
30 口閥門的載出腔（證據9之後置機台19）、一銜接該入口閥
31 門的載入腔（證據9之前置機台18），及一銜接於該載出腔

01 與該載入腔之間的回送機構（證據9之回傳機構模組40），
02 該回送機構具有一對應載出腔設置的沉降段（證據9之後升
03 降壓缸30）、一對應該載入腔設置的舉升段（證據9之前升
04 降壓缸30）及一連接該沉降段與該舉升段的中繼段（證據9
05 之滾輪41、單向運轉動力源42及傳動元件43）。其中，證據
06 9固未揭露系爭專利以腔體形式呈現的載入腔以及載出腔。
07 然而，是否將載入及載出部分以腔體方式形式呈現，明顯為
08 所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成，故於證據9
09 已完全揭示請求項10所界定的自動回流單元，以架構於連續
10 式真空鍍膜產線中，達到自動化閉迴路連續式作業流程之情
11 形下，所屬技術領域中具有通常知識者結合證據5至證據9及
12 甲證3，當可輕易完成系爭專利請求項10之內容，足證系爭
13 專利請求項10不具進步性。

14 三、被告聲明求為判決原告之訴駁回，並抗辯：

15 (一)證據6不足以證明系爭專利請求項1不具進步性：

16 1.證據6之圖5雖然已揭示緩衝區間與鍍膜區間依序輪流設置於
17 一腔體內，即系爭專利請求項1(n=2)之結構特徵部分，惟未
18 揭示系爭專利請求項1中的方法特徵，且該方法特徵非所屬
19 技術領域中具有通常知識者可輕易完成者。由證據6說明書
20 第0021段至0025段所揭示使用其雙面覆膜設備之具體步驟，
21 所屬技術領域中具有通常知識者可合理推知，其為單一(批
22 次)待鍍物進入第一沉積空間完成第一道鍍覆程序後再進入
23 第二沉積空間完成另一表面之鍍覆，並無法知悉當有兩個以
24 上之待鍍物進入該雙面覆膜設備時，該如何移動待鍍物，而
25 原告僅單純以證據6的圖5之示意圖，進一步臆測待鍍物於覆
26 膜設備中之操作程序即可同步往右移動，實屬無理由，故所
27 屬技術領域中具有通常知識者並無法輕易推及系爭專利請求
28 項1之方法特徵。

29 2.證據6之圖3、圖5及其說明書內容所揭示待鍍物於第一沉積
30 空間完成第一表面濺鍍後，再進入第二沉積空間進行第二表
31 面濺鍍，主要以完成整個該待鍍物之雙面覆膜，反觀系爭專

01 利係於一載具之同一面上依序完成第一膜層及第二膜層。再
02 者，證據6之創作目的在於簡化被動元件之雙面覆膜之製程
03 週期，而系爭專利在於利用鍍膜生產線之依序輪流配置之緩
04 衝區與鍍膜區間，並配合載具同時進入相對應到鍍膜程序，
05 以有效利用各鍍膜區間並提高生產線利用率，兩者之差異甚
06 巨。

07 (二)證據5至證據7及甲證3之組合不足以證明系爭專利請求項1不
08 具進步性：

09 甲證3說明書揭示一種直列式連續沉積裝置，其具有六個沉
10 積腔(213、214、215…218)及相對應的六個緩衝腔(213a、2
11 14a…218a)，亦即一個鍍膜區間搭配一個緩衝區間，與系爭
12 專利請求項1步驟(a)具有(n+1)個緩衝區間與 n 個鍍膜區間
13 之結構特徵並不相同。又甲證3圖1B揭示當三個基板10位於
14 沉積裝置之相對位置之示意圖，其中第一個(從左邊數來)基
15 板位於第一緩衝腔(213a)，第二個基板位於第二沉積腔(21
16 4)，第三個基板位於第三沉積腔(215)，然而，系爭專利若
17 當有三個載具時，其三個必須同時分別在三個緩衝區間或同
18 時分別在三個鍍膜區間，非甲證3所示基板有同時在緩衝腔
19 與沉積腔之情形。因此，甲證3未揭示系爭專利請求項1之結
20 構特徵與方法特徵。而證據5揭示內容，其僅一個濺鍍室(n=
21 1)，濺鍍室與前後緩衝室並非設置於一真空腔體內，其結構
22 特徵與系爭專利請求項1不同，利用系爭專利請求項1結構特
23 徵而操作之方法特徵亦不相同，且藉由證據5僅揭示之多個
24 基板同步移動往返兩緩衝區進行濺鍍工作，所屬技術領域中
25 具有通常知識者亦難以推知系爭專利請求項1之方法特徵。
26 再者，證據7所揭示內容與系爭專利請求項1中結構特徵並不
27 相同，遑論利用系爭專利請求項1結構特徵而操作之方法特
28 徵。是以，證據5至證據7及甲證3之組合，不足以證明系爭
29 專利請求項1不具進步性。

30 (三)證據5至證據8及甲證 3 之組合不足以證明系爭專利請求項
31 2至9不具進步性：

證據5至證據7及甲證 3 之組合，不足以證明系爭專利請求項1不具進步性，業已敘明。證據8仍未揭示系爭專利請求項1中方法特徵，如舉發審定書理由(五)、3、(1)、B 中所述，故證據5至證據8及甲證 3 之組合，不足以證明系爭專利請求項 1不具進步性，是以依附於請求項1之請求項2至9亦非所屬技術領域中具有通常知識者而能輕易完成者。

(四)證據5至證據9及甲證3 之組合不足以證明系爭專利請求項10不具進步性：

證據5至證據8及甲證3之組合不足以證明系爭專利請求項1不具進步性，業已敘明。證據9仍未揭示系爭專利請求項1中方法特徵，如舉發審定書理由(五)、5、(1)、B中所述，故證據5至證據9及甲證3之組合，不足以證明系爭專利請求項1不具進步性，是以依附於請求項1之請求項10亦非所屬技術領域中具有通常知識者而能輕易完成者。

四、參加人聲明求為判決原告之訴駁回，並主張：

(一)證據6不足以證明系爭專利請求項1不具進步性：

證據6並未揭示系爭專利請求項1之技術特徵1E、1F及1G，且通常知識者無法輕易推及系爭專利請求項1之所有技術特徵。證據6所揭示的鍍膜程序完全不同於系爭專利請求項1所界定之內容，所屬技術領域中具有通常知識者無法由證據6所揭示的內容，推及系爭專利所界定的鍍膜程序，因此，系爭專利請求項1相對於證據6確具進步性無疑。

(二)證據5至7及甲證3之組合不足以證明系爭專利請求項1不具進步性：

1.證據5是一次使2個基板進入同一個濺鍍腔進行鍍膜程序，與系爭專利請求項1之技術特徵1E、1F及1G所界定之同時令第二個載具與第一個載具分別於第一個鍍膜區間與第二個鍍膜區間內執行第一道鍍膜程序與第二道鍍膜程序，乃分別使第一個載具與第二個載具進入不同濺鍍腔執行不同道鍍膜程序，二者載入濺鍍腔之方式、位置關係及鍍膜程序完全不

同，因此，證據5未揭示系爭專利請求項1之技術特徵1E、1F及1G之技術特徵。

2.證據7揭示一種選擇性與可控性地偏壓托盤上多個基材的設備及方法。證據7所揭示之鍍膜設備包含一系列多個真空腔體，各真空腔體並由多個閘門G所區隔，而非位於同一真空腔體中，因此證據7並未揭示系爭專利請求項1技術特徵1C。證據7僅揭示複數基材可以線性方式橫向通過至少一處理站，但並未揭示系爭專利請求項1技術特徵1E、1F及1G。

3.甲證3說明書揭示具有6個緩衝腔以及6個沉積腔，其與系爭專利請求項1中特徵1C所界定之「具有 $(n+1)$ 個緩衝區間、 n 個鍍膜區間與多個載具的鍍膜生產線」，並不相同。系爭專利所界定者，係同一時間內，只有鍍膜區間或緩衝區間會有載具存在；因此，甲證3揭示步驟與系爭專利不同，其並未揭示系爭專利請求項1的技術特徵1E、1F及1G。是以，甲證3並未揭示系爭專利請求項1之技術特徵1C、1E、1F及1G。

4.證據5、證據7、甲證3與證據6之結構特徵均不同，所屬技術領域中具有通常知識者即欠缺動機而將此四者組合，證據5至7及甲證3的組合，完全不同於系爭專利請求項1所界定之內容，也並未揭示系爭專利請求項1技術特徵1E、1F及1G；本發明所屬技術領域中具有通常知識者就該等多重差異部分，在所有證據均未有任何教示或建議下，不可能藉由簡單之轉用、置換、修飾等手段而輕易完成。再者，依照系爭專利說明書段落[0013]、[0033]可知，利用在同一真空腔室內輪流配置的緩衝區間及鍍膜區間，並配合載具同時進入相對應之各鍍膜區間內執行各道鍍膜程序時，是於各鍍膜區間之兩相鄰緩衝區間位移，使各鍍膜區間內同時執行各道鍍膜程序而無閒置狀態，不僅可避免待鍍物長時間暴露於各鍍膜區間之靶材下方處之電漿區所致過熱問題，避免待鍍物因過熱變形而影響鍍膜品質，同時有效利用各鍍膜區間並提高生產線利用率，故而大幅提升產能，益證系爭專利請求項1具進步性無疑。

01 (三)證據5至8及甲證3之組合不足以證明系爭專利請求項2至9不
02 具進步性；且證據5至9及甲證3之組合不足以證明系爭專利
03 請求項10不具進步性：

04 由於原告所舉之證據或證據組合所示內容，均與系爭專利請
05 求項1有所歧異，未能完全揭示系爭專利請求項1之所有技術
06 特徵，且原告所舉證據或證據組合亦均未對於該等技術差異
07 有所教示、建議，因此本發明所屬技術領域中具有通常知識
08 者，無法徒以上開證據組合即輕易完成系爭專利請求項1之
09 所有技術特徵。此外，證據8係原告用以證明系爭專利請求
10 項2進一步界定之腔體數量變更的特徵不具進步性之佐證；
11 證據9則係原告用以證明系爭專利請求項10進一步界定鍍膜
12 生產線額外的機構（如出入口閥門、傳輸機構、回流單元等
13 等）；綜觀證據8及證據9兩者，證據8僅於說明書段落[008
14 3]至[0088]說明單一樣品在製備裝置中，連續製備薄膜的過
15 程；而證據9則只揭示在連續式真空鍍膜中設置潛入式內部
16 迴流裝置，兩者完全未論及系爭專利請求項1中針對多個待
17 鍍物進行多道鍍膜的步驟。因此，此二證據也無法影響系爭
18 專利請求項1的進步性。又系爭專利請求項1之獨立項既具有
19 進步性，則系爭專利請求項2至請求項10等附屬項因包含系
20 爭專利請求項1之所有技術特徵，自亦具有進步性。

21 五、本件法官依行政訴訟法第132條準用民事訴訟法第271條之
22 1、第270條之1第1項第3款、第3項規定，整理兩造及參加人
23 不爭執事項並協議簡化爭點如下：□

24 (一)不爭執事項：□

25 如事實及理由欄貳、實體事項、一、事實概要所示。

26 (二)本件爭點：

27 1.證據6或證據5至7及甲證3之組合是否可證明系爭專利請求項
28 1不具進步性？

29 2.證據5至8及甲證3之組合是否可證明系爭專利請求項2至9不
30 具進步性？

31 3.證據5至9及甲證3之組合是否可證明系爭專利請求項10不具

進步性？

六、得心證之理由：

(一)按發明專利權得提起舉發之情事，依其核准審定時之規定，專利法第71條第3項本文定有明文。本件系爭專利之申請日為103年12月15日，審定日為104年10月30日，是系爭專利有無撤銷之原因，自應以其核准審定時所適用之103年1月22日修正公布、同年3月24日施行之專利法(下稱核准時專利法)為斷。

(二)按凡利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用者，得依法申請取得發明專利，為系爭專利核准時專利法第21條及第22條第1項前段所規定。又發明如「為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時」，不得取得發明專利，同法第22條第2項復有明文。而對於獲准專利權之發明，任何人認有違反前揭專利法規定者，依法得附具證據，向專利專責機關提起舉發。從而，系爭專利有無違反前揭專利法情事而應撤銷其專利權，依法應由舉發人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭專利有違前揭專利法之規定，自應為舉發不成立之處分。

(三)系爭專利技術分析

1.系爭專利技術內容：

系爭專利為多層膜的量產方法，是令多數待鍍物進行多道鍍膜程序並依序包含(a)提供具 $(n+1)$ 個緩衝區間、 n 個鍍膜區間及多個載具的鍍膜生產線，緩衝區間與鍍膜區間沿一排列方向輪流設於一真空腔體內；(b)於第一個緩衝區間載入置有第一個待鍍物的第一個載具；(c)令第一個載具於第一個鍍膜區間執行第一道鍍膜程序時是於第一、二個緩衝區間位移數次；(d)令第一個載具位於第二個緩衝區間且同時於第一個緩衝區間載入置有第二個待鍍物的第二個載具；及(e)同時令第二與第一個載具於第一與第二個鍍膜區間執行第一與第二道鍍膜程序時是各於第一、二個與第二、三個緩衝區間位移數次（系爭專利【摘要】參照）。

01 2.系爭專利主要圖式如本判決附圖一所示。

02 3.系爭專利申請專利範圍分析：

03 系爭專利申請專利範圍共計10項，其中請求項1為獨立項，
04 其餘均為附屬項，其內容如下：

05 請求項1：一種多層膜的量產方法，是用以將多數待鍍物進
06 行多道鍍膜程序，其包含以下步驟：一步驟(a)，
07 提供一具有(n+1)個緩衝區間、n個鍍膜區間與多
08 個載具的鍍膜生產線，該等緩衝區間與該等鍍膜
09 區間是沿一排列方向依序輪流設置於一真空腔體
10 內， $n \geq 2$ 且是正整數；一步驟(b)，於該鍍膜生產
11 線的第一個緩衝區間或第二個緩衝區間載入放置
12 有第一個待鍍物的第一個載具；一步驟(c)，於該
13 步驟(b)後，令第一個載具於第一個鍍膜區間執行
14 第一道鍍膜程序以於第一個待鍍物上形成一第一
15 膜層時，是於該第一、二個緩衝區間兩者間位移
16 至少一次；一步驟(d)，於該步驟(c)後，令第一
17 個載具位於第二個緩衝區間或第三個緩衝區間，
18 且同時於該鍍膜生產線的第一個緩衝區間或第二
19 個緩衝區間載入放置有第二個待鍍物的第二個載
20 具，但有條件的是，當第二個載具位於第二個緩
21 衝區間時，第一個載具是位於第三個緩衝區間；
22 及一步驟(e)，於該步驟(d)後，同時令第二個載
23 具與第一個載具分別於第一個鍍膜區間與第二個
24 鍍膜區間內執行第一道鍍膜程序與第二道鍍膜程
25 序，以分別於第二個待鍍物上與第一個待鍍物之
26 上形成該第一膜層與一第二膜層時，是同時分別
27 於第一、二個緩衝區間兩者間與第二、三個緩衝
28 區間兩者間位移至少一次，但有條件的是，當第
29 二個載具位於第二個緩衝區間時，第一個載具是
30 位於第三個緩衝區間。

31 請求項2：如請求項1所述的多層膜的量產方法，還包含一步

01 驟(f)及一步驟(g)，且 $n=3$ ，其中，該步驟(f)，
02 於該步驟(e)後，令第一個載具位於第三個緩衝區
03 間或第四個緩衝區間，且同時令第二個載具位於
04 第二個緩衝區間或第三個緩衝區間，並同時於該
05 鍍膜生產線的第一個緩衝區間或第二個緩衝區間
06 載入放置有第三個待鍍物的第三個載具，但有條
07 件的是，當第三個載具位於第二個緩衝區間時，
08 第二個載具是位於第三個緩衝區間，且第一個載
09 具是位於第四個緩衝區間；及該步驟(g)，於該步
10 驟(f)後，同時令第三個載具、第二個載具與第一
11 個載具分別於第一個鍍膜區間、第二個鍍膜區間
12 與第三個鍍膜區間內執行第一道鍍膜程序、第二
13 道鍍膜程序與第三道鍍膜程序，以分別於第三個
14 待鍍物上、第二個待鍍物之上與第一個待鍍物之
15 上形成該第一膜層、該第二膜層與一第三層膜時
16 ，是同時分別於第一、二個緩衝區間兩者間、第
17 二、三個緩衝區間兩者間與第三、四個緩衝區間
18 兩者間位移至少一次，但有條件的是，當第三個
19 載具位於第二個緩衝區間時，第二個載具是位於
20 第三個緩衝區間且第一個載具是位於第四個緩衝
21 區間。

22 請求項3：如請求項2所述的多層膜的量產方法，其中，該步
23 驟(b)是於該鍍膜生產線的第一個緩衝區間載入放
24 置有第一個待鍍物的第一個載具；該步驟(d)是令
25 第一個載具位於第二個緩衝區間，且同時於該鍍
26 膜生產線的第一個緩衝區間載入放置有第二個待
27 鍍物的第二個載具。

28 請求項4：如請求項3所述的多層膜的量產方法，其中，該步
29 驟(f)是令第一個載具位於第三個緩衝區間，且同
30 時令第二個載具位於第二個緩衝區間，並同時於
31 該鍍膜生產線的第一個緩衝區間載入放置有第三

個待鍍物的第三個載具。

請求項5：如請求項1所述的多層膜的量產方法，其中，該步驟(e)之第二個載具與第一個載具分別於第一個鍍膜區間與第二個鍍膜區間內執行第一道鍍膜程序與第二道鍍膜程序時所耗費的時間相同。

請求項6：如請求項5所述的多層膜的量產方法，其中，該步驟(e)之第二個載具與第一個載具，分別於第一、二個緩衝區間兩者間與第二、三個緩衝區間兩者間所位移的次數相同，且所位移的速率相同。

請求項7：如請求項2所述的多層膜的量產方法，其中，該步驟(g)之第三個載具、第二個載具與第一個載具分別於第一個鍍膜區間、第二個鍍膜區間與第三個鍍膜區間內執行第一道鍍膜程序、第二道鍍膜程序與第三道鍍膜程序時所耗費的時間相同。

請求項8：如請求項7所述的多層膜的量產方法，其中，該步驟(g)之第三個載具、第二個載具與第一個載具，分別於第一、二個緩衝區間兩者間、第二、三個緩衝區間兩者與第三、四個緩衝區間兩者間所位移的次數相同，且所位移的速率相同。

請求項9：如請求項1至8任一請求項所述的多層膜的量產方法，其中，該步驟(a)之每一個鍍膜區間包括至少一鍍膜段，且該等鍍膜段是分別以一靶材來執行各鍍膜程序，該等靶材是由不同材質所構成或由相同材質所構成。

請求項10：如請求項1至8任一請求項所述的多層膜的量產方法，其中，該步驟(a)之該鍍膜生產線還具有一分別設置於該真空腔體之相反兩端的一入口閥門、一出口閥門、一連續地設置於該等緩衝區間和該等鍍膜區間內用以傳輸該等載具的傳輸機構，及一供該等載具自該出口閥門回流至該入口閥門的自動回流單元，該自動回流單元包括一銜接該出

口閥門的載出腔、一銜接該入口閥門的載入腔，
及一銜接於該載出腔與該載入腔之間的回送機構
，該回送機構具有一對應載出腔設置的沉降段、
一對應該載入腔設置的舉升段，及一連接該沉降
段與該舉升段的中繼段。

(四)舉發證據技術分析：

1.證據5公告日為1994年8月23日，早於系爭專利之申請日（2014年12月25日），可作為系爭專利申請前之先前技術。證據5揭露一種用於塗布基板(1、1'...)之方法與設備，較佳者係於由至少一濺射腔室(6)組成之一真空設備中透過陰極濺射完成，其中可將不同塗佈系統實施於較佳為彎曲的待塗布基板(1、1'...)，該等基板(1、1'...)可於一方向B上透過真空設備移動，並於方向B上反覆通過濺射腔室(6)以及於所謂之多程模式中通過相反方向，於進入濺射腔室前，將未塗布之基板(1、1'...)或基板載體(12、11'...)結合為多個群組，較佳者係各為兩個基板(1、1'...)，此等係以所謂之雙重多程模式同時穿過該濺射腔室(6)（參證據5摘要），證據5主要圖式如本判決附圖二所示。

2.證據6公告日為2012年11月11日，早於系爭專利之申請日（2014年12月25日），可作為系爭專利申請前之先前技術。證據6為一種適用於被動元件之雙面覆膜設備，包括載入腔體、等離子體清潔腔體、第一低壓腔體、製程腔體、第二低壓腔體、載出腔體以及輸送系統。待鍍物於製程腔體內即可完成被動元件之雙面覆膜之製程。證據6精簡了被動元件之雙面覆膜之製程週期，進而降低了製程之複雜度以及成本。另更可維持製程腔體內之低壓之一致性。此外，待鍍物可於第一緩衝空間、第二緩衝空間或第三緩衝空間內，被進行緩衝動作，可進一步增加進行被動元件之雙面覆膜之製程時之流暢度（參證據6摘要），證據6主要圖式如本判決附圖三所示。

01 3.證據7公告日為2005年1月18日，早於系爭專利之申請日（20
02 14年12月25日），可作為系爭專利申請前之先前技術。證據
03 7揭露一種直線型多工位設備，包含一改良托盤，用於輸送
04 複數工件/基材通過該設備，該托盤包括：(a)一導電材料
05 片，具有至少部分延伸穿過其中之複數間隔區域，各區域經
06 採用以於其中設置並暴露出對應之工件/基材的至少一主表
07 面以接受處理；以及(b)多個電接點手段，用於選擇性與可
08 控性地電連接各該等複數工件/基材，以於處理期間對其施
09 加一電偏壓電位。實施例包括直線型設備，用於在多層磁性
10 及/或磁光記錄媒體之製造中對絕緣基材上之導電薄膜進行
11 偏壓濺射（參證據7摘要），證據7主要圖式如本判決附圖四
12 所示。

13 4.證據8公告日為2013年8月21日，早於系爭專利之申請日（20
14 14年12月25日），可作為系爭專利申請前之先前技術。證據
15 8揭露一種規模化連續製備二維納米薄膜的裝置，包括進料
16 腔室、處理腔室、第一平衡腔室、第一薄膜製備腔室、第二
17 平衡腔室、第二薄膜製備腔室、第三平衡腔室、化學氣相沉
18 積腔室和出料腔室等各腔室之間設有閥門，樣品通過傳送裝
19 置實現在各腔室之間的連續傳輸；薄膜製備腔室設有物理氣
20 相沉積系統和化學氣相沉積系統，並設有加熱裝置和氣體
21 連介面等；整套裝置設有自動化控制系統以控制腔室之間的
22 閥門的開關、樣品的傳輸、氣體流量的控制、抽真空等。利
23 用本設備，可以規模化連續製備石墨烯、金屬硫族化合物、
24 矽烯、鍺烯或氮化硼等二維納米膜。本設備具有連續成膜
25 的特徵，可以在不同腔室實現規模化連續製備二維納米薄膜
26 的所需的襯底/催化層以及樣品預處理等，適合於二維納米薄
27 膜的產業化製備（參證據8摘要），證據8主要圖式如本判決
28 附圖五所示。

29 5.證據9公告日為2005年3月1日，早於系爭專利之申請日（20
30 14年12月25日），可作為系爭專利申請前之先前技術。證據9
31 揭露一種自動化潛入式內部迴流裝置，是設有一位於連續生

01 產設備前、後端的前升降裝置、後升降裝置、至少一延伸於
02 前、後升降裝置之間並且位在連續生產設備下方的回傳機構
03 模組，該前、後升降裝置上設有雙向運轉動力源以及數只被
04 驅動轉動的滾輪，而回傳機構模組則設有單向運轉動力源以
05 及數只被驅動的滾輪，待作業的物品是置於前升降裝置頂
06 部，輸送至生產設備內作業之後，再輸送至後升降裝置，後
07 升降裝置下降至回傳機構模組的高度，再經由回傳機構模組
08 輸送至前升降裝置取出，再置入待生產物件（參證據9摘
09 要），證據9主要圖式如本判決附圖六所示。

10 6. 甲證3公開日為2012年9月20日，早於系爭專利之申請日（20
11 14年12月25日），可作為系爭專利申請前之先前技術。甲證
12 3揭露一種連續成膜裝置。該裝置包括：第二沉積室；第三
13 沉積室耦合到第二沉積室；傳送單元，用於將基板從第二沉
14 積室傳送到第三沉積室；多個第三沉積源在第二沉積室中沿
15 基板傳送方向排列；第四和第五沉積源在第三沉積室中沿傳
16 送方向交替布置。在第三沉積室中，第四沉積源放置在最靠
17 近第二沉積源的位置。第四沉積源包含主體材料，第五沉積
18 源包含摻雜劑材料（參甲證3摘要），甲證3主要圖式如本判
19 決附圖七所示。

20 (五)證據6不足以證明系爭專利請求項1不具進步性：

21 1. 系爭專利請求項1所界定之技術特徵如下：

22 技術特徵1A：「一種多層膜的量產方法」

23 技術特徵1B：「是用以將多數待鍍物進行多道鍍膜程序，其
24 包含以下步驟：」

25 技術特徵1C：「一步驟(a)，提供一具有(n+1)個緩衝區間、
26 n個鍍膜區間與多個載具的鍍膜生產線，該等
27 緩衝區間與該等鍍膜區間是沿一排列方向依序
28 輪流設置於一真空腔體內， $n \geq 2$ 且是正整數；
29 」

30 技術特徵1D：「一步驟(b)，於該鍍膜生產線的第一個緩衝
31 區間或第二個緩衝區間載入放置有第一個待鍍

01 物的第一個載具；」

02 技術特徵1E：「一步驟(c)，於該步驟(b)後，令第一個載具
03 於第一個鍍膜區間執行第一道鍍膜程序以於第
04 一個待鍍物上形成一第一膜層時，是於該第一
05 一、二個緩衝區間兩者間位移至少一次；」

06 技術特徵1F：「一步驟(d)，於該步驟(c)後，令第一個載具
07 位於第二個緩衝區間或第三個緩衝區間，且同
08 時於該鍍膜生產線的第一個緩衝區間或第二個
09 緩衝區間載入放置有第二個待鍍物的第二個載
10 具，但有條件的是，當第二個載具位於第二個
11 緩衝區間時，第一個載具是位於第三個緩衝區
12 間；及」

13 技術特徵1G：「一步驟(e)，於該步驟(d)後，同時令第二個
14 載具與第一個載具分別於第一個鍍膜區間與第
15 二個鍍膜區間內執行第一道鍍膜程序與第二道
16 鍍膜程序，以分別於第二個待鍍物上與第一個
17 待鍍物之上形成該第一膜層與一第二膜層時，
18 是同時分別於第一、二個緩衝區間兩者間與第
19 二、三個緩衝區間兩者間位移至少一次，但有
20 條件的是，當第二個載具位於第二個緩衝區間
21 時，第一個載具是位於第三個緩衝區間。」

22 2.將系爭專利請求項1與證據6相較，可知證據6說明書段落[00
23 33]至[0034]與圖4至5揭示被動元件之雙面覆膜設備之第二
24 較佳實施例，該設備用以處理多個待鍍物，其製程腔體4具
25 有彼此連通且依序設置之第一緩衝空間41、第一沉積空間4
26 2、第三緩衝空間45、第二沉積空間43以及第二緩衝空間4
27 4，[0037]揭示製程腔體4具有的第二內部壓力係小於第一低
28 壓腔體3具有的第一內部壓力或第二低壓腔體5具有的第三內
29 部壓力，[0038]揭示可使用沉積治具來裝載待鍍物， [003
30 3]記載第二較佳實施例之運作步驟可由第一較佳實施例之運
31 作步驟輕易地推測得知，復參照[0014]至[0029]段揭示適用

於被動元件之雙面覆膜設備之第一較佳實施例的運作步驟，
步驟400包括輸送待鍍物至製程腔體內之第一緩衝空間41，
步驟500包括輸送待鍍物至製程腔體內之第一沉積空間42，
再進行沉積製程於待鍍物之至少一第一表面，前述沉積製程
例如為等離子製程、蒸鍍製程、離子鍍製程、電弧鍍製程或
化學氣相沉積製程（當採用第二較佳實施例時，待鍍物於前
述沉積製程後，應會自第一沉積空間42被輸送至製程腔體之
第三緩衝空間45），步驟600包括輸送待鍍物至製程腔體內
之第二沉積空間43（當採用第二較佳實施例時，待鍍物係自
第三緩衝空間45被輸送至第二沉積空間43），再進行沉積製
程於待鍍物之至少一第二表面，步驟700包括輸送待鍍物至
製程腔體內之第二緩衝空間44。證據6所揭示雙面覆膜設備
係用以將多個待鍍物進行多道鍍膜程序，其具有(2+1)個緩
衝區間（第一緩衝空間41、第三緩衝空間45及第二緩衝空間
44）與2個鍍膜區間（第一沉積空間42及第二沉積空間4
3），該等緩衝區間與該等鍍膜區間是沿一排列方向依序輪
流設置於一腔體內（製程腔體4），於第一個緩衝區間（第
一緩衝空間41）載入待鍍物，令待鍍物於第一個鍍膜區間
（第一沉積空間42）執行第一道鍍膜程序以於其上形成第一
表面膜層時，是於第一、二個緩衝區間（第一緩衝空間41及
第三緩衝空間45）兩者間位移至少一次，再令待鍍物於第二
個鍍膜區間（第二沉積空間43）執行第二道鍍膜程序以於其
上形成第二表面膜層時，是於第二、三個緩衝區間（第三緩
衝空間45及第二緩衝空間44）兩者間位移至少一次，然而系
爭專利請求項1與證據6間仍存有以下差異：(1)證據6未具體
記載製程腔體4為真空腔體；(2)證據6未敘及在（第一個）
待鍍物被輸送至第三緩衝空間45，同時於第一緩衝空間41載
入放置有第二個待鍍物的第二個載具，並在（第一個）待鍍
物於第二沉積空間43進行沉積製程的同時令該第二個載具於
第一沉積空間42內進行沉積製程，以分別於該第二個待鍍物
上與（第一個）待鍍物上形成一第一表面膜層與第二表面膜

層時，是同時分別於該第一緩衝空間41、第三緩衝空間45兩者間與第三緩衝空間45、第二緩衝空間44兩者間位移至少一次。

3.發明所屬技術領域中具有通常知識者利用申請時之通常知識，應可使製程腔體為真空，以利鍍膜製程進行，而完成上開差異(1)。惟關於上開差異(2)，證據6說明書段落[0021]至[0022]記載待鍍物被輸送至製程腔體內之第一緩衝空間，接著關閉第一低壓腔體及製程腔體之間的閘門，[0005]揭示創作目的包括在進行雙面覆膜製程時，維持製程腔體內之低壓一致性，[0037]揭示製程腔體具有的內部壓力小於第一低壓腔體或第二低壓腔體具有的內部壓力，是以發明所屬技術領域中具有通常知識者在利用證據6所述雙面覆膜技術對多個待鍍物進行鍍膜程序時，應會使該等待鍍物整批次輸送至第一緩衝空間41（多個待鍍物係同時載入第一個緩衝區間），關閉第一低壓腔體與製程腔體之間的閘門後，再進行待鍍物於製程腔體內的輸送及沉積製程，亦即製程期間前述閘門應保持關閉以維持製程腔體內之低壓一致性；倘若採用如系爭專利請求項1技術特徵1F所述步驟(d)，於第一個待鍍物進行第一道鍍膜程序後，令第一個待鍍物位於第三緩衝空間，且同時於第一緩衝空間載入第二個待鍍物（需打開第一低壓腔體與製程腔體之間的閘門，始能進行待鍍物的輸送），即無法於雙面覆膜製程中維持製程腔體內之低壓一致性而有違證據6之創作目的。再者，證據6圖5雖示有多個待鍍物，然全篇並未揭示或教示多個待鍍物於雙面覆膜設備中應如何作動（包括相對移動過程），此等靜態圖示是否即已足使發明所屬技術領域中具有通常知識者特定採用如系爭專利請求項1技術特徵1G所述步驟(e)，亦即令第二個待鍍物與第一個待鍍物分別於第一沉積空間與第二沉積空間進行沉積製程，以分別於第二個待鍍物與第一個待鍍物上形成第一表面膜層與第二表面膜層時，是同時分別於第一緩衝空間41、

01 第三緩衝空間45兩者間與第三緩衝空間45、第二緩衝空間44
02 兩者間位移至少一次，尚非無疑。

03 4.系爭專利請求項1所請發明可於量產多層膜時，利用依序輪
04 流配置的緩衝區間與鍍膜區間，配合複數載具同時進入相對
05 應的各鍍膜區間內執行各道鍍膜程序時，是於各鍍膜區間之
06 兩相鄰緩衝區間位移，使各鍍膜區間內是同時執行各道鍍膜
07 程序且未呈現出閒置狀態，以有效地利用各鍍膜區間並提高
08 鍍膜生產線的利用率（參系爭專利說明書段落【0013】）；
09 相對地，證據6所配置之第一緩衝空間、第二緩衝空間或第
10 三緩衝空間係為使待鍍物於原處等待或調整傳輸速度，以增
11 加雙面覆膜製程之流暢度（參證據6說明書段落[0043]等
12 處），並未敘及使多個待鍍物同時進入相對應的鍍膜區間同
13 時執行各道鍍膜程序，以提高鍍膜生產線利用率之目的。

14 5.綜上，證據6並未揭示或教示系爭專利請求項1所界定之技術
15 特徵1F及1G，發明所屬技術領域中具有通常知識者亦無動機
16 將證據6所揭示雙面覆膜運作步驟進行簡單變更而完成系爭
17 專利請求項1之發明的整體，且該等技術特徵所達成之提高
18 鍍膜生產線利用率等功效，亦非基於證據6而可預期者，難
19 謂發明所屬技術領域中具有通常知識者依證據6而能輕易完
20 成系爭專利請求項1之發明，是以，證據6不足以證明系爭專
21 利請求項1不具進步性。

22 6.原告主張「可以推知的，第一待鍍物由第一低壓腔體3往第
23 二低壓腔體5的方向進行鍍膜程序，亦即由圖面之左方往右
24 方前進而進行鍍膜時，第一待鍍物勢必會先位於第一個緩衝
25 區間41，而此時，第二待鍍物仍在製程腔體4之左方，尚未
26 進入製程腔體」云云（參原告行政訴訟起訴狀第17至18
27 頁）。惟查，發明所屬技術領域中具有通常知識者在利用證
28 據6所述雙面覆膜技術對多個待鍍物進行鍍膜程序時，應會
29 使該等待鍍物整批次輸送至第一緩衝空間41（多個待鍍物係
30 同時載入第一個緩衝區間），其理由業如前述，亦即第一待
31 鍍物與第二待鍍物應會同時位於第一個緩衝區間41，關閉第

一低壓腔體3及製程腔體4之間的閘門後，始開始第一待鍍物及第二待鍍物在製程腔體4內的雙面覆膜程序。倘如原告所為推論「第一待鍍物位於第一個緩衝區間41之時，第二待鍍物仍在製程腔體4之左方而尚未進入製程腔體」，則應於第一待鍍物依序經過第一緩衝空間41、第一沉積空間42、第三緩衝空間45、第二沉積空間43、第二緩衝空間44而完成雙面覆膜程序後，方能打開第一低壓腔體3及製程腔體4之間的閘門以將第二待鍍物輸送至第一緩衝空間41，否則即無法於第一待鍍物之雙面覆膜製程中維持製程腔體4內之低壓一致性，違反證據6之創作目的；然依上開移動方式，第一待鍍物位於第二沉積空間43之時，第二待鍍物應尚未進入製程腔體，第一待鍍物與第二待鍍物自無可能呈現如證據6圖5所示位置，因此原告基於證據6圖5所為上開推論，應非可採。

7.原告雖主張「由證據6之第5圖所示，第一待鍍物與第二待鍍物係分別位於第二沉積空間43以及第一沉積空間42，所屬技術領域中具有通常知識者可輕易知悉當第一待鍍物與第二待鍍物同步由左方往右方移動時，第一待鍍物與第二待鍍物會分別先位於第三緩衝空間45以及第一緩衝空間41，而可對應於步驟(d)……如第5圖所示，第一待鍍物與第二待鍍物正分別位於第二沉積空間43以及第一沉積空間42進行鍍膜程序，所屬技術領域中具有通常知識者可知悉，當第一待鍍物與第二待鍍物同步往右移動，而分別位移至第二緩衝空間44以及第三緩衝空間45……而對應於步驟(e)之條件」云云（參原告行政訴訟起訴狀第19頁）。然查，縱如原告所述「第一待鍍物與第二待鍍物會分別先位於第三緩衝空間45以及第一緩衝空間41」，仍無法對應於系爭專利請求項1所載步驟(d)，蓋因第二待鍍物與第一待鍍物應係整批次被載入第一緩衝空間41，並非第一待鍍物位於第三緩衝空間45之時始將第二待鍍物載入第一緩衝空間41，其理由已如前述。況且，證據6全篇未揭示或教示多個待鍍物於雙面覆膜設備中應如何作動（包括相對移動過程），圖5亦僅為靜態圖示，原告逕稱第

一待鍍物與第二待鍍物同步由左方往右方移動，所屬技術領域中具有通常知識者可輕易知悉圖5之前狀態與後狀態，實為由證據6未記載內容所衍生之空泛推論，原告前開主張容有落入「後見之明」之疑慮。

- 8.原告復主張「證據6第5圖已明確揭示當第一待鍍物（三個）位於第二沉積空間43進行第二道鍍膜程序時，而第二待鍍物（兩個）正位於第一沉積空間42進行第一道鍍膜程序，是以證據6第5圖已明確揭露系爭專利步驟(e)之內容……於系爭專利申請日前所具備之通常知識可知：『呈現同一方向排列的鍍膜生產線，其上載具僅能有三個動作：前進、後退、原地停止』、『待鍍物於執行各鍍膜製程時可來回位移多次』…所述技術領域中具有通常知識者自然可以輕易推測得知該第一待鍍物的前一狀態正位於第三緩衝區間，後一狀態會位於第二緩衝空間；而該第二待鍍物的前一狀態正位於第一緩衝區間，後一狀態會位於第三緩衝空間…」（參原告行政訴訟起訴狀第21至22頁），是以，原處分與訴願決定之審查均有違誤或不符法令之情事，應予撤銷等云云。但查，證據6圖5僅為靜態圖示，實難謂有明確揭露系爭專利請求項1步驟(e)所界定之複數待鍍物進行鍍膜程序時的同時位移過程。縱將原告所述「呈現同一方向排列的鍍膜生產線，其上載具僅能有三個動作：前進、後退、原地停止」、「待鍍物於執行各鍍膜製程時可來回位移多次」等內容列入所屬技術領域中具有通常知識者之技術水平進行考量，則證據6圖5中第一待鍍物的前一狀態可能位於第三緩衝區間45（前進至第二沉積空間43）、第二緩衝區間44（後退至第二沉積空間43）或第二沉積空間43（於第二沉積空間43原地停止），後一狀態可能位於第二緩衝區間44（自第二沉積空間43前進）、第三緩衝區間45（自第二沉積空間43後退）或第二沉積空間43（於第二沉積空間43原地停止），證據6圖5中第二待鍍物的前一狀態可能位於第一緩衝區間41（前進至第一沉積空間42）、第三緩衝區間45（後退至第一沉積空間42）或第一沉積空

01 間42（於第一沉積空間42原地停止），後一狀態可能位於第
02 三緩衝區間45（自第一沉積空間42前進）、第一緩衝區間41
03 （自第一沉積空間42後退）或第一沉積空間42（於第一沉積
04 空間42原地停止），可知第一待鍍物與第二待鍍物進行鍍膜
05 程序之相對移動過程（由其前後狀態排列組合）更有多種可
06 能，發明所屬技術領域中具有通常知識者是否可自證據6圖5
07 之靜態圖示輕易推測得知複數待鍍物進行鍍膜程序時之特定
08 移動過程，已非無疑，遑論預期能有效地利用各鍍膜區間並
09 提高鍍膜生產線的利用率等功效，輕易完成系爭專利請求項
10 1之發明。是以，原告此部分之主張應不足採。

11 (六)證據5至7及甲證3之組合不足以證明系爭專利請求項1不具進
12 步性：

13 1.證據6並未揭示或教示系爭專利請求項1所界定之技術特徵1F
14 及1G，已如前述。證據5說明書第2欄第39至55行及圖1揭示
15 多程濺射設備，依序包括閘閥3、入口腔室2、閘閥3'、緩
16 衝腔室4、閘閥3''、輸送腔室5、濺射腔室6、輸送腔室
17 9、閘閥3'''、緩衝腔室10、閘閥3''、出口腔室11及閘閥
18 3，第3欄第11行至第4欄第11行及圖2揭示雙重多程程序，程
19 序步驟1表示初始狀態在入口腔室2、緩衝腔室4及輸送腔室5
20 各置有基板1''、1'及1，步驟2係將基板1'自緩衝腔室4
21 移動至輸送腔室5，步驟3顯示隨後基板1''自入口腔室2進
22 入緩衝腔室4，此時於輸送腔室5內同時存有兩基板1'及1，
23 步驟4係將一基板1'''裝載至入口腔室2中，開始該雙重
24 多程程序，將兩基板1'及1輸送至濺射腔室6中提供第一塗
25 層，步驟5顯示將前述兩基板1'及1送至輸送腔室9而位於等
26 待位置，步驟6係將前述兩基板1'及1沿與先前移動方向B相
27 反之方向E通過濺射腔室6進入輸送腔室5，並於該濺射腔室6
28 中將第二塗層施於該等基板1'及1上，步驟7則將前述兩基
29 板1'及1沿方向B穿過濺射腔室6並施加第三塗層，基板
30 1''及1'''與已塗佈之基板1'及1同時各推進一腔室，
31 結束時回到如步驟1之初始位置而可展開另一雙重多程程

01 序，上述基板1、1' ……其加工步驟亦可透過載體12、1
02 2' ……描述。證據5所揭示多程濺射程序係用以將多數待鍍
03 物（基板）往復進行多道鍍膜程序，惟查，證據5僅記載緩
04 衝腔室4、緩衝腔室10及濺射腔室6，前述緩衝腔室與濺射腔
05 室之間尚存在閘閥及輸送腔室，是以證據5未揭示 $n \geq 2$ 個鍍
06 膜區間，且緩衝腔室與濺射腔室間並非設置於一真空腔體內
07 （系爭專利1請求項1技術特徵1C）；另證據5之基板1' 載入
08 緩衝腔室4後，係進一步移動至輸送腔室5，復與基板1同步
09 輸送至濺射腔室6中提供第一塗層，隨後在輸送腔室9等待，
10 亦即基板於濺射腔室6執行鍍膜程序形成塗層時，並未於緩
11 衝腔室4及緩衝腔室10間位移至少一次（系爭專利1請求項1
12 技術特徵1E），亦未有使基板位於緩衝腔室10且同時於緩衝
13 腔室4載入另一基板（系爭專利1請求項1技術特徵1F），以
14 及進而使兩基板分別於兩個濺射腔室內執行鍍膜程序等技術
15 內容（系爭專利1請求項1技術特徵1G）。

16 2.證據7說明書第8欄第55行至第9欄第19行及圖1至2揭示直線
17 型連續設備10，其包括由複數閘門手段G互連之一系列線性
18 細長真空腔室，包括複數處理腔室或工位，如一對處理腔室
19 或工位1、1' 所示，其各包括至少一個（較佳為一對）相互
20 間隔、彼此相對之線性細長處理源2、2' （例如選自各種物
21 理氣相沉積PVD源，例如真空蒸發、濺射、離子鍍等來
22 源……），用以對雙面工件之兩側面同時進行處理，以及位
23 於對應處理腔室或工位1、1' 之相對側端之一對緩衝/隔離
24 腔室如3、3' 及3' 、3' '，分別用於插入和取出複數垂直
25 定向之工件/基材，如複數碟型基材4，其等係由如例示手段
26 5、5' 所示者所承載，藉此各該等相對表面於連續輸送通過
27 設備10時係面向對應之線性細長處理源2、2' 。證據7所揭
28 示之設備10可用以將多數待鍍物（基材4、4' ）進行多道鍍
29 膜程序，其具有 $(2+1)$ 個緩衝區間（緩衝/隔離腔室3、3' 、
30 3' '）、2個鍍膜區間（處理腔室或工位1、1' ）及多個載
31 具（手段5、5' ），該等緩衝區間與該等鍍膜區間沿一排列

01 方向依序輪流設置，惟緩衝區間與鍍膜區間之間設有閘門手
02 段G，並非設置於一真空腔體內（系爭專利1請求項1技術特
03 徵1C）；再者，證據7圖1至2雖示有多個待鍍物，並以箭頭
04 表示位於處理腔室或工位1、1' 中的載具5、5' 之接續移動
05 方向，且由其設置可知待鍍物於處理腔室或工位1執行第一
06 道鍍膜程序而形成第一膜層時，應有於緩衝/隔離腔室3、
07 3' 兩者間位移至少一次，然而證據7除於說明書第8欄第51
08 至54行記載複數工件/基材係以線性路徑橫向輸送通過至少
09 一處理工位以外，並未具體揭示或教示多個待鍍物於直線型
10 連續設備10中應如何作動（包括相對移動過程），此等靜態
11 圖示是否即已足使發明所屬技術領域中具有通常知識者特定
12 採用如系爭專利請求項1技術特徵1F及1G所述步驟(d)至
13 (e)，亦即載具5' 通過處理腔室或工位1執行第一道鍍膜程
14 序而形成第一膜層後，令載具5' 位於緩衝/隔離腔室
15 3' 時，始同時將載具5載入緩衝/隔離腔室3（而非一開始即
16 於緩衝/隔離腔室3整批次載入載具5、5' ），再同時令載具
17 5、5' 分別於處理腔室或工位1、1' 內執行第一道鍍膜程序
18 及第二道鍍膜程序，以分別於基材4、4' 上形成第一膜層與
19 第二膜層時，是同時分別於緩衝/隔離腔室3、3' 兩者間及
20 緩衝/隔離腔室3' 、3' ' 兩者間位移至少一次（而非分別
21 控制載具5、5' 之移動過程），仍有可以懷疑之處。

- 22 3. 甲證3說明書段落[0045]至[0048]、圖1A至1C揭示直列式連
23 續沉積裝置200，包括預處理部212、第一沉積腔213、第二
24 沉積腔214、第三沉積腔215、第四沉積腔216、第五沉積腔2
25 17、第六沉積腔218及後處理部219，預處理部212包括一裝
26 載區212a及一預處理腔212b，裝載區212a係一腔體，複數基
27 板10於大氣壓力下載入並堆疊於此腔體中，而後以排空單元
28 將壓力降低至可開始進行沉積之程度，第一至第六沉積腔21
29 3~218各設有緩衝部213a~218a，相鄰之腔體係透過經由所
30 述緩衝部213a~218a相連，緩衝部可防止自鄰接蒸發腔進入
31 之沉積材料在沉積時進入薄膜，第一至第六沉積腔213~218

各具有排空單元。甲證3所揭示之直列式連續沉積裝置200可用以將多數待鍍物（複數基板10）進行多道鍍膜程序，惟其沉積腔與緩衝部數目相等，且每一沉積腔各自具有排空單元，於圖中亦可見沉積腔與緩衝部並未相連通，是以甲證3所揭示沉積腔與緩衝部數目並非 n 與 $n+1$ 之關係，且非設置於一真空腔體內（系爭專利1請求項1技術特徵1C）；再者，甲證3圖1A至1C雖示有多個待鍍物，並以箭頭表示位於沉積腔或緩衝部中的基板之接續移動方向，然而第一沉積腔213前方並未設置緩衝部，圖中可見之三個基板亦非同時位於三個沉積腔或同時位於三個緩衝部，甲證3全篇更未揭示或教示複數基板於直列式連續沉積裝置200中應如何作動（包括相對移動過程），此等靜態圖示是否即已足使發明所屬技術領域中具有通常知識者在第一沉積腔213前方再行設置一緩衝部並特定採用如系爭專利請求項1技術特徵1D、1E、1F及1G所述步驟(b)至(e)，亦即於「另外設置之緩衝部」載入基板，令基板於第一個沉積腔213執行第一道鍍膜程序以形成第一膜層時，是於「另外設置之緩衝部」及緩衝部213a兩者間位移至少一次，復令基板位於緩衝部213a且同時於「另外設置之緩衝部」載入另一基板，再同時令兩個基板分別於第一個沉積腔213及第二個沉積腔214內執行第一道鍍膜程序及第二道鍍膜程序，以分別於兩個基板上形成第一膜層與第二膜層時，是同時分別於「另外設置之緩衝部」及緩衝部213a兩者間、以及緩衝部213a、214a兩者間位移至少一次，還有疑義。

4. 雖證據5至7及甲證3均記載沉積/鍍膜裝置，具有技術領域之關連性，然而，證據5係使基板往復通過單一濺射腔室而於其單面進行多道鍍膜程序，證據6係先通過一沉積空間以於待鍍物之一面覆膜、再通過另一沉積空間以於待鍍物之另一面覆膜，證據7乃使基材通過複數處理腔室且每一處理腔室均對基材之兩側面同時進行鍍膜，甲證3則係使基板直列式通過多個沉積腔而於其單面進行多道鍍膜程序，顯見該等證

據之鍍覆型態各異，所欲解決之問題與功能、作用難謂有共通性，各證據中亦無明確記載或實質隱含結合不同證據之技術內容的教示或建議，發明所屬技術領域中具有通常知識者難謂有動機結合證據5至7及甲證3；縱使勉強結合該等證據，由於證據5至7及甲證3所記載之沉積/鍍膜裝置皆係基於不同鍍覆型態所設計者，仍無從恣意擷取並拼湊裝置部件，更不必論及特定採用如系爭專利請求項1所述多層膜的量產方法（特別是技術特徵1F及1G之步驟(d)至(e)所述之複數載具的載入及相對移動過程）。

5.系爭專利請求項1所請發明可於量產多層膜時，利用依序輪流配置的緩衝區間與鍍膜區間，配合複數載具同時進入相對應的各鍍膜區間內執行各道鍍膜程序時，是於各鍍膜區間之兩相鄰緩衝區間位移，使各鍍膜區間內是同時執行各道鍍膜程序且未呈現出閒置狀態，以有效地利用各鍍膜區間並提高鍍膜生產線的利用率（參系爭專利說明書段落【0013】）；相對地，證據5藉由緩衝腔室4暫存待塗佈基板，以使待塗佈基板或乘載該等基板之載體成組結合並同時通過單一濺射腔室（參證據5說明書第2欄第8至13行、第3欄第11行至第4欄第11行等處），證據6所配置之第一緩衝空間、第二緩衝空間或第三緩衝空間係為使待鍍物於原處等待或調整傳輸速度，以增加雙面覆膜製程之流暢度（參證據6說明書段落[0043]等處），證據7之緩衝/隔離腔室3、3'及3''係用於插入和取出複數垂直定向之工件/基材（參證據7說明書第9欄第1至15行），甲證3之緩衝部係為防止自鄰接蒸發腔進入之沉積材料在沉積時進入薄膜（參甲證3說明書段落[0048]等處），可知證據5至7及甲證3均未敘及使多個待鍍物同時進入相對應的鍍膜區間同時執行各道鍍膜程序，以提高鍍膜生產線利用率之目的。

6.綜上，證據5至7及甲證3之任一者均至少未揭示或教示系爭專利請求項1所界定之技術特徵1F及1G，且發明所屬技術領域中具有通常知識者並無合理動機結合證據5至7及甲證3，

縱使勉強結合該等證據，亦無從恣意擷取並拼湊裝置部件，遑論思及採用特定之複數載具的載入及相對移動過程，完成系爭專利請求項1之發明整體，況該等技術特徵所達成之提高鍍膜生產線利用率等功效，並非基於證據5至7及甲證3而可預期者，難謂發明所屬技術領域中具有通常知識者依證據5至7及甲證3之組合而能輕易完成系爭專利請求項1之發明，是以，證據5至7及甲證3之組合不足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

7.原告主張「證據5已揭示兩個基板依序設置於製程產線中，進行濺鍍塗覆作業，且可於濺射腔室6、前後腔室5、9（非濺射腔室）三者間往返……所屬技術領域中具有通常知識者可以藉由證據5所教示的多個基板同步前後移動，而至少可將證據6第5圖中的多個待鍍物於製程腔體4中同步的前後移動」及「藉由證據5所揭示之技術手段『多個基板可依序進入濺鍍區進行濺鍍』以及『可以來回往返兩個緩衝區，多次經過濺鍍區而達到多層鍍膜的目的』結合證據6…用以證明系爭專利請求項1不具進步性」及「證據5中的腔體5及9可以對應至系爭專利請求項1之緩衝區間」云云（參原告行政訴訟起訴狀第25至28頁及本院卷第475頁之112年2月9日言詞辯論筆錄）。惟查，證據5說明書第3欄第11行至第4欄第11行及圖2揭示雙重多程程序，基板1'及1係同步輸送至單一濺射腔室6中提供第一塗層，復被送至輸送腔室9等待，隨後折返通過單一濺射腔室6中提供第二塗層，進入輸送腔室5後又折返通過單一濺射腔室6並施加第三塗層，顯未記載基板1'及1來回往返緩衝腔室4及緩衝腔室10；證據5明確記載腔室5及腔室9均為輸送腔室，腔室4及腔室10始為緩衝腔室，其定義與功能有別，實無從逕將證據5之輸送腔室5及9對應為系爭專利請求項1之緩衝區間。因此，原告主張證據5揭示技術手段「可以來回往返兩個緩衝區，多次經過濺鍍區而達到多層鍍膜的目的」，顯屬無據。再者，證據5及證據6間缺乏足夠結合動機，業如前述；縱使勉強結合，證據5揭示

「同於濺射腔室6中進行相同鍍膜程序之兩基板1'、1」成組結合並同步移動，該等基板1、1'與另一成組結合之基板1'、1'，並未同時移動（例如步驟5中，基板1、1'沿方向B前進，基板1'、1'維持不動），則藉由證據5之教示，發明所屬技術領域中具有通常知識者至多可使證據6圖5中同於第二沉積空間43進行相同鍍膜程序的三個待鍍物（原告標示為第一待鍍物者）同時移動，同於第一沉積空間42進行相同鍍膜程序的兩個待鍍物（原告標示為第二待鍍物者）同時移動，執行不同鍍膜程序之第一待鍍物與第二待鍍物應未必於製程腔體4中同步移動。是以，原告此部分之主張不可採。

- 8.原告雖主張「原處分逕以證據5有閘門即認其非屬同一真空腔體，但又並未論述證據5之閘門對於系爭專利請求項1之同一真空腔體的差異，其論理亦顯無所據」、「證據7之鍍膜裝置的各緩衝室3、3'、3'及各物理氣相沉積源2、2'間雖設有閘門G，惟對於沉積鍍膜作業而言…閘門G並不影響鍍膜作業的進行…斷不能僅因證據7與系爭專利在閘門設置上有差異，而刻意忽視該等差異是否實質影響系爭專利之技術…閘門之設置與否，根本完全不實質影響系爭專利請求項1之技術特徵判斷，顯然的，系爭專利請求項1之結構特徵，至多僅為證據7之簡單變更而已」及「系爭專利請求項1界定同一真空腔體，屬於證據5及證據7之『省略式技術特徵』」、「系爭專利請求項1相較於證據7少了閘門的設置，僅僅是無法達到證據7利用閘門來避免不同濺鍍區的濺鍍粒子或個別腔體真空度調整功能，除此之外並無其他，故系爭專利請求項1僅僅只是證據7的技術省略而已」及「參加人主張待鍍物可在鍍膜區間與緩衝區間移動，不會曝露在電漿區而有過熱問題，但事實上，閘門開啟也可以使待鍍物移動於鍍膜區間與緩衝區間，並不影響濺鍍的程序」云云（參原告行政訴訟起訴狀第28、30至32頁、原告112年1月9日庭呈簡報第22頁、原告行政訴訟準備(一)狀第12頁及本院卷第475

頁之112年2月9日言詞辯論筆錄)。然按針對申請專利之發明與單一引證之技術內容二者的差異技術特徵，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者於解決特定問題時，能利用申請時之通常知識，將單一引證之差異技術特徵簡單地進行修飾、置換、省略或轉用等而完成申請專利之發明者，則該發明為單一引證之技術內容的「簡單變更」，發明專利審查基準第二篇第三章第3.4.1.2節可資參照；至於閘閥/閘門之省略是否實質影響系爭專利之技術，例如是否確能避免過熱問題，應為有利功效之考量，而無涉簡單變更的判斷。原告以「閘閥/閘門與過熱問題無關」為由，稱系爭專利請求項1之真空腔體屬於證據5及證據7之「省略式技術特徵」，此等主張顯與簡單變更之判斷不符。雖原告進一步提出專利審查基準第二篇第三章第3.4.1.2節所述內容，稱系爭專利請求項1僅僅只是證據7的技術省略而已，然而發明所屬技術領域中具有通常知識者是否會僅為了節省元件之目的，將證據7明確記載之重要元件「閘門手段G」予以省略，尚非無疑（參照證據7說明書第8欄第55至59行，一系列線性細長真空腔室係由複數閘門手段G互連）。再者，若鍍膜區間與緩衝區間之間未經閘門區隔，則待鍍物依系爭專利請求項1所載方式移動時，即可在鍍膜程序完畢後立即移動至緩衝區間，無須於鍍膜區間費時等候閘門開啟，可知閘門之省略並非「僅喪失所省略閘門之功能而已」，其對於避免待鍍物因長時間暴露於鍍膜區間靶材下方的電漿區所致的過熱問題，亦有一定助益。綜上，原告之主張實難採。況查，系爭專利請求項1相較於信證據7之差異並非僅在閘門之有無。如前所述，證據7未具體揭示多個待鍍物之相對移動過程，且即便結合證據7與證據5、6及甲證3，發明所屬技術領域中具有通常知識者仍無從特定採用如系爭專利請求項1所述多層膜的量產方法（特別是技術特徵1F及1G之步驟(d)至(e)所述之複數載具的載入及相對移動過程），更無從預期提高鍍膜生產線利用率等功效，因此仍無助於否定系爭專利請求項1之進步性。

01 9.原告又主張「證據7第8欄第51～54行……配合證據7之FIG. 1
02 及FIG. 2，其已揭示載具5（在此稱為第二載具）位於處理腔
03 室1，載具5'（在此稱為第一載具）位於處理腔室1'中，
04 並且由FIG. 2圖面之箭頭表示可知第二載具5以及第一載具
05 5'的行進方向為由左往右，藉此可回推其移動過程……上
06 述處理程序的進行為所屬技術領域中具有通常知識者依照FI
07 G. 2，將第一載具5'與第二載具5同步進行前後位移便能輕
08 易推知，而能完成系爭專利請求項1之所有技術特徵」及
09 「使FIG. 2中的兩個載具5同步移動是所屬技術領域中具有通
10 常知識者『最直覺』、『最直觀』的判斷」云云（參原告行
11 政訴訟起訴狀第32至35頁及原告行政訴訟準備(一)狀第10至
12 11頁）。惟查，證據7圖2僅為靜態圖示，箭頭亦僅表示位於
13 處理腔室或工位1、1'中的載具5、5'之接續移動方向，並
14 未具體揭示或教示多個待鍍物於直線型連續設備10中應如何
15 作動（包括相對移動過程），難謂足使發明所屬技術領域中
16 具有通常知識者特定採用如系爭專利請求項1技術特徵1F及1
17 G所述步驟(d)至(e)，其理由已如前述。原告逕稱將第一載
18 具5'與第二載具5同步進行前後位移，便能輕易推知證據7
19 圖2的前一動作與後一動作，並主張同步移動是最直覺、最
20 直觀的判斷等，實為由證據7未記載內容所衍生之空泛推
21 論，其前開主張實有「後見之明」之疑慮。

22 10.原告復主張「甲證3亦已明確揭露系爭專利請求項1之結構特
23 徵…甲證3已揭露3個緩衝區間（標號213a、214a、215a…甲
24 證3已揭露2個鍍膜區間（標號214、215…甲證3亦揭露有多
25 個基板間隔排列而可依序同步移動進行濺鍍工作…同一方向
26 排列的鍍膜生產線中，將載具進行往前、往後、原地停止、
27 速度調整，都僅為所屬技術領域中之通常知識而已」及「同
28 步移動是最簡單。最容易完成的製程方式」云云（參原告行
29 政訴訟起訴狀第36至38頁及原告112年1月9日庭提簡報第27
30 頁）。然查，甲證3揭示內容如前所述，其鍍膜生產線實為
31 具有6個緩衝區間（緩衝部213a至218a）及6個鍍膜區間（沉

積腔213至218)；甲證3圖1B及1C僅為鍍膜生產線之一部分示意圖，並不表示具有緩衝部213a、沉積腔214、緩衝部214a、沉積腔215及緩衝部215a之鍍膜生產線即可執行甲證3所述鍍膜技術，原告擷取甲證3圖1B及1C而非完整檢視甲證3技術內容為主張，應非可採。甲證3圖1A至1C僅為靜態圖示，箭頭亦僅表示位於沉積腔與緩衝部中的基板之接續移動方向，甲證3全篇更未揭示或教示複數基板於直列式連續沉積裝置200中應如何作動（包括相對移動過程），原告逕稱甲證3揭露有多個基板可依序同步移動，實為由甲證3未記載內容所衍生之空泛推論，原告前開主張亦容有落入「後見之明」之疑慮。依原告所述，將載具進行往前、往後、原地停止、速度調整，都僅為所屬技術領域中之通常知識而已，則複數基板於直列式連續沉積裝置200的相對移動過程即有極多種可能，並非必然為同步移動；況且甲證3圖中可見之三個基板並非同時位於三個沉積腔或同時位於三個緩衝部，是以縱使採取同步移動方式，仍無從完成如系爭專利請求項1所述使複數載具於各鍍膜區間內同時執行各道覆膜程序之技術。

(七)證據5至8及甲證3之組合不足以證明系爭專利請求項2至9不具進步性：

1.證據5至8及甲證3之組合不足以證明系爭專利請求項1不具進步性：

(1)證據5至7及甲證3未揭示或教示系爭專利請求項1所界定之技術特徵1F及1G，以及發明所屬技術領域中具有通常知識者依證據5至7及甲證3之組合無從輕易完成系爭專利請求項1發明整體，業如前述。

(2)證據8說明書第[0069]段揭示規模化連續製備二維奈米薄膜的基本過程，包含在第一薄膜製備腔室4利用物理氣相沉積系統將催化層製備在襯底上，然後經過第二平衡腔室5，被傳送到第二薄膜沉積腔室6；在第二薄膜製備腔室6，利用物理氣相沉積系統將二維奈米薄膜的前驅體離化在催化層上，然後經過第三平衡腔室7，被傳送到化學氣相

01 沉積腔室8；在化學氣相沉積腔室8，對樣品進行處理而形成二維奈米薄膜。由上可知，證據8雖揭示三個濺鍍腔室
02 成二維奈米薄膜。由上可知，證據8雖揭示三個濺鍍腔室
03 ，但仍至少未揭示或教示系爭專利請求項1所界定之技術
04 特徵1F及1G。

05 (3)因此，縱使於證據5至7及甲證3進一步結合證據8，發明所
06 屬技術領域中具有通常知識者仍無從恣意擷取並拼湊裝置
07 部件，遑論思及採用特定之複數載具的載入及相對移動過
08 程，完成系爭專利請求項1之發明整體，並預期能提高鍍
09 膜生產線利用率等功效，難謂發明所屬技術領域中具有通
10 常知識者依證據5至8及甲證3之組合而能輕易完成系爭專
11 利請求項1之發明，是以，證據5至8及甲證3之組合不足以
12 證明系爭專利請求項1不具進步性。

13 2.承上，既然證據5至8及甲證3之組合不足以證明系爭專利請
14 求項1不具進步性，自亦不足以證明依附於請求項1而具有進
15 一步技術特徵之請求項2至9不具進步性。

16 (八)證據5至9及甲證3之組合不足以證明系爭專利請求項10不具
17 進步性：

18 1.證據5至9及甲證3之組合不足以證明系爭專利請求項1不具進
19 步性：

20 (1)證據5至8及甲證3未揭示或教示系爭專利請求項1所界定之
21 技術特徵1F及1G、以及發明所屬技術領域中具有通常知識
22 者依證據5至8及甲證3之組合無從輕易完成系爭專利請求
23 項1發明整體，已如前述。

24 (2)證據9說明書第11頁第4至5段及圖1、圖2揭示利用原有之
25 連續式真空鍍膜生產裝置，而形成一潛入式內部迴流裝置
26 ，其依序設有連續真空鍍膜所需的進料腔體區(10)、鍍膜
27 腔體區(11)、出料腔體區(12)，各腔體區內分別設有一動
28 力輸出設備(13)，以分別驅動一組輸送滾輪(14)轉動，而
29 各腔體區是分別承置於一進料基台、一鍍膜基台、一出料
30 基台上，又於三基台之間設有一回傳機構模組(40)，該回
31 傳機構模組(40)設有數個呈水平併列之滾輪(41)，其設置

01 方向與前述輸送滾輪(14)相同，各滾輪(41)是被一單向運
02 轉動力源(42)透過如鏈條、皮帶等傳動元件(43)所帶動呈
03 同向旋轉，又於回傳機構模組(40)上方以及兩側邊以一防
04 塵蓋，該防塵蓋與滾輪之間的距離需可供承載盤(50)通過
05 。由上可知，證據9雖揭示自動回流單元，但仍未揭示或
06 教示系爭專利請求項1所界定之技術特徵1F及1G。

07 (3)因此，縱使於證據5至8及甲證3進一步結合證據9，發明所
08 屬技術領域中具有通常知識者仍無從恣意擷取並拼湊裝置
09 部件，遑論思及採用特定之複數載具的載入及相對移動過
10 程，完成系爭專利請求項1之發明整體，並預期能提高鍍
11 膜生產線利用率等功效，難謂發明所屬技術領域中具有通
12 常知識者依證據5至9及甲證3之組合而能輕易完成系爭專
13 利請求項1之發明，是以，證據5至9及甲證3之組合不足以
14 證明系爭專利請求項1不具進步性。

15 2.承上，既然證據5至9及甲證3之組合不足以證明系爭專利請
16 求項1不具進步性，自亦不足以證明依附於請求項1而具有進
17 一步技術特徵之請求項10不具進步性。

18 七、綜上所述，本件證據6或證據5至7及甲證3之組合不足以證明
19 系爭專利請求項1不具進步性；證據5至8及甲證3之組合不足
20 以證明系爭專利請求項2至9不具進步性；證據5至9及甲證3
21 之組合不足以證明系爭專利請求項10不具進步性。從而，被
22 告以系爭專利請求項1至10未違反核准時專利法第22條第2項
23 規定，為舉發不成立之原處分，其理由雖與本院不同，惟結
24 論並無二致，仍應予維持，則訴願決定維持原處分，亦無違
25 誤。原告仍執前詞，請求撤銷訴願決定及原處分，並命被告
26 應作成「請求項1至10舉發成立，應予撤銷」之審定，為無
27 理由，應予駁回。

28 八、本件判決基礎已經明確，當事人其餘攻擊防禦方法及訴訟資
29 料經本院斟酌後，認與判決結果沒有影響，無逐一論述必
30 要，併此說明。

九、據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

中華民國 112 年 2 月 23 日

智慧財產第二庭

審判長法官 彭洪英

法官 汪漢卿

法官 曾啓謀

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。

上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第241條之1第1項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。

得不委任律師為訴訟代理人之情形	所需要件
（一）符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人	1. 上訴人或其法定代理人具備律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2. 稅務行政事件，上訴人或其法定代理人具備會計師資格者。 3. 專利行政事件，上訴人或其法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
（二）非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人	1. 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。

01

- | | |
|--|--|
| | <p>2. 稅務行政事件，具備會計師資格者。</p> <p>3. 專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。</p> <p>4. 上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。</p> |
|--|--|

是否符合（一）、（二）之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出（二）所示關係之釋明文書影本及委任書。
--

02

中 華 民 國 112 年 3 月 6 日

03

書記官 丘若瑤